

Silicon Diode

BAS33

30V / 200mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

BAS 33 · BAS 34

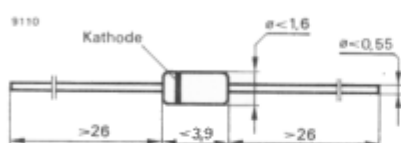
Silizium-Planar-Dioden

Anwendungen: Schutzschaltungen, Verzögerungsschaltungen

Besondere Merkmale:

- Sehr niedriger Sperrstrom

Abmessungen in mm



Standard Glasgehäuse
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht max. 0,15 g

Absolute Grenzwerte

Sperrspannung	BAS 33	U_R	30	V
	BAS 34	U_R	60	V
Stoßdurchlaßstrom $t_p = 1 \mu s$		I_{FSM}	2	A
Durchlaßstrom		I_F	200	mA
Sperrschichttemperatur		T_j	200	°C
Lagerungstemperaturbereich		T_{stg}	- 65 + 200	°C

Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung $l = 4 \text{ mm}, T_L = \text{konstant}$	R_{thJA}	350	K/W
--	------------	-----	-----

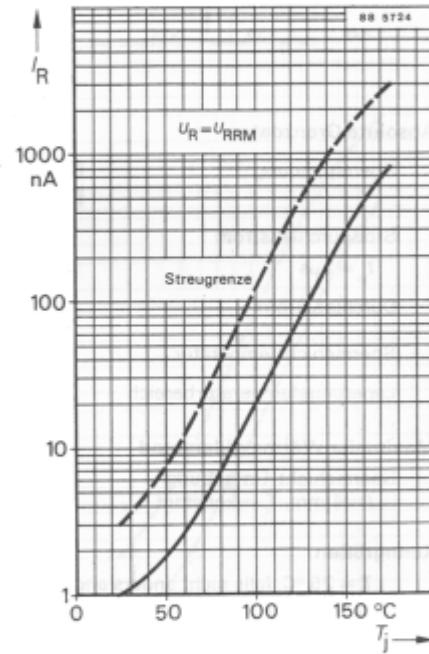
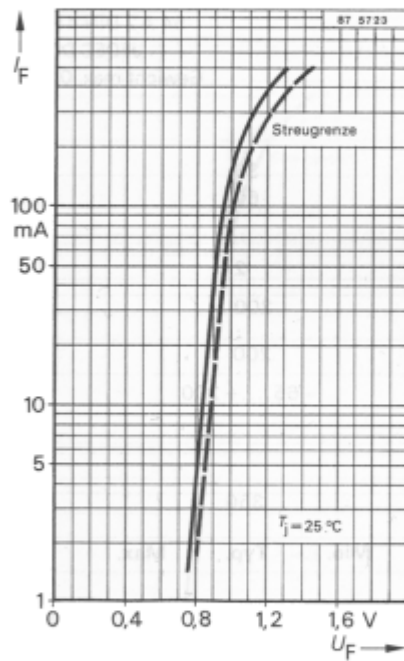
Kenngößen

		Min.	Typ.	Max.	
$T_j = 25 \text{ °C}$, falls nicht anders angegeben					
Durchlaßspannung $I_F = 100 \text{ mA}$	U_F			1	V
Sperrstrom $E^{1)} \leq 500 \text{ lx}, U_R$	I_R		1	3	nA
$U_R, T_j = 125 \text{ °C}$	I_R			0,5	µA
$U_R = 15 \text{ V}$	BAS 33	I_R	0,5	1	nA
$U_R = 30 \text{ V}$	BAS 34	I_R	0,5	1	nA

¹⁾ Beleuchtungsstärke

BAS 33 · BAS 34

			Min.	Typ.	Max.
Durchbruchspannung $I_R = 5 \mu\text{A}$	BAS 33	$U_{(BR)}^{1)}$	40		V
	BAS 34	$U_{(BR)}^{1)}$	70		V
Diodenkapazität $U_R = 0, f = 1 \text{ MHz}$		C_D			3 pF



¹⁾ $\frac{t_p}{T} = 0,01, t_p = 0,3 \text{ ms}$